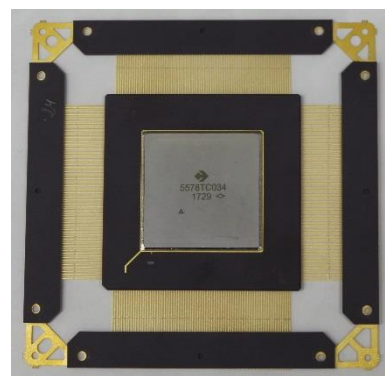


ПЛИС 5578ТС034

ТУ – АЕНВ0431260.216ТУ

Энергонезависимая рад.-стойкая однократно-программируемая ПЛИС, может быть использована для замены следующих аналогов: EPF10K100E (ф. Altera), RT54SX72S, A54SX72A, RTSX72SU, AX125, APA075 ф. Microsemi, XC2S100 ф. Xilinx. Выпускается с категорией качества «ВП».

Корпус: 4251.304–2



ПЛИС имеет следующие основные режимы функционирования:

- режим отладки проекта до однократного программирования конфигурационной памяти ПЛИС, в котором возможно многократно конфигурировать ПЛИС по интерфейсу JTAG;
- режим однократного программирования ПЛИС;
- рабочий режим, в котором ПЛИС функционирует после процесса однократного программирования конфигурационной памяти в соответствии с разработанным пользователем проектом.

Напряжение питания ядра, В	1,8 ± 5%
Напряжение питания периферии, В	3,3 ± 0,3
Диапазон температур окружающей среды, °С	от минус 60 до плюс 100
Типовая логическая ёмкость, вент.	100 000
Количество системных вентиляей	109 056
Объем встроенной памяти, Кбит	48
Количество эквивалентных логических элементов	4 992
Количество выводов, программируемых пользователем	212
Среда конфигурирования	MAX + Plus II или Quartus II (не позднее версии 8.1) и доп. ПО разработанного АО «КТЦ ЭЛЕКТРОНИКА», г. Воронеж
Программируемые блоки удержания выводов пользователя в последнем состоянии (режим Bus-Hold)	имеются
Программируемые блоки установления и поддержки на выводах пользователя высокого/низкого логического уровня (режим Pull-Up/Pull-Down)	имеются
Режим «холодного резервирования»	имеется
Блок служебной памяти пользователя	имеется

Требования по стойкости к воздействию специальных факторов

Условное обозначение микросхемы	Значение характеристики специальных факторов								
	7.И ₁ ¹⁾	7.И ₆ ²⁾	7.И ₇	7.И ₈	7.С ₁	7.С ₄	7.К ₁	7.К ₄	7.К ₁₁ , 7.К ₁₂ ²⁾
5578ТС034	4У _С	5У _С	5У _С	0,1·1У _С	5У _С	5·5У _С	$\frac{0,5 \cdot 2K^{3)}}{10 \cdot 2K^{4)}$	0,5·2K ³⁾⁴⁾	60 МэВ·см ² /мг

¹⁾ По структурным повреждениям.
²⁾ По катастрофическим отказам (КО) и тиристорному эффекту (ТЭ).
³⁾ При совместном воздействии факторов 7.К с характеристиками 7.К₁, 7.К₄.
⁴⁾ При независимом воздействии факторов 7.К с характеристиками 7.К₁, 7.К₄.